doi: 10.56761/EFRE2022.S6-P-028802

# Моделирование предпробойных явлений в микровыступе на катоде в СВЧ полях с учетом движения расплава

И. Уйманов<sup>1,\*</sup>, Д. Шмелев<sup>1</sup>, С. Баренголь $\mu^{2,3}$ 

<sup>1</sup>Институт электрофизики УрО РАН, Екатеринбург, Россия <sup>2</sup>Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия <sup>3</sup>Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия \*uimanov67@yandex.ru

**Абстракт.** Разработана самосогласованная двумерная осесимметричная модель, описывающая нагрев микровыступа и динамику формы его вершины после плавления в СВЧ поле. Модель включает в себя расчет напряженности электрического поля и эмиссионных характеристик на "эмиссионной" полуволне СВЧ волны методом "частицы в ячейке" (PIC) с учетом объемного заряда эмитированных электронов, и с момента плавления вершинной части микровыступа описывает движение жидкой фазы под действием сил со стороны электрического поля и сил поверхностного натяжения. Проведено моделирование разогрева микровыступа до критической температуры и изменения формы его вершинной части с начальным коэффициентом усиления напряженности электрического поля  $\beta_m \sim 86$  в СВЧ волне с модулем напряженности 250 МВ/м и частотой 10 ГГц. Показано, что время развития тепловой неустойчивости при вытягивании и заострении микровыступа в расплавленном состоянии существенно ниже, чем в случае неизменной формы микровыступа. При этом эмиссионный источник выделения тепла (эффект Ноттингема) всегда остается греющим, а максимальная температура достигается на поверхности вершины микровыступа.

Ключевые слова: вакуумный пробой, СВЧ пробой, термоавтоэлектронная эмиссия

#### 1. Введение

Взрыв микровыступов на катоде рассматривается как основной механизм вакуумного пробоя как в постоянных импульсных, так и в радиочастотных электрических полях [1-4]. Интерес к исследованию механизма радиочастотного вакуумного пробоя возник в связи с развитием мощной импульсной микроволновой электроники [5]. Радиочастотный вакуумный пробой является одной из основных причин эффекта «укорочения длительности» импульса мощного СВЧ излучения [6]. Преодоление этого эффекта позволило бы существенно увеличить эффективность использования энергии сильноточных электронных пучков для генерации микроволнового излучения. В последние годы интерес к явлению радиочастотного вакуумного пробоя резко возрос в связи с разработкой электронпозитронных коллайдеров [7]. Радиочастотный вакуумный пробой на поверхности ускоряющей структуры является основной причиной, препятствующей увеличению градиента ускорения частиц [8]. В настоящее время можно с уверенностью утверждать, что в основе наносекундного радиочастотного вакуумного пробоя и импульсного вакуумного пробоя лежит единый механизм, связанный с микровзрывными процессами на поверхности электродов под действием тока взрывной электронной эмиссии [9, 10]. Об этом свидетельствует, прежде всего, наличие идентичных следов поражения поверхности электродов - кратеров микрометрового размера на поверхности. Экспериментально установлен рост вероятности пробоя с увеличением разогрева поверхности ускоряющей структуры под действием СВЧ поля [11]. Проведенные нами расчеты показали, что при росте начальной температуры микроострия до 1000 К, время его разогрева протекающим током автоэлектронной эмиссии до критической температуры снижается в 1.5–2 раза в зависимости от плотности тока [12].

Однако, в известных нам подходах, рассмотрение предвзрывных явлений в микровыступе не учитывало динамику формы микровыступа после его плавления. С целью исследования этих процессов в данной работе разработана двумерная осесимметричная

самосогласованная модель нагрева микровыступа с учетом изменения его формы после плавления под действием СВЧ поля и сил поверхностного натяжения.

### 2. Описание модели

#### 2.1. Постановка задачи

Модельная геометрия задачи представлена на Рис.1. Конический микровыступ высотой  $h_m$ , с полууглом раствора  $\alpha$  и радиусом вершины  $r_{
m m}$  находится в гармоническом электрическом поле СВЧ волны амплитудой  $E_w = 250$  MB/м и частотой w = 10 ГГц. Во время "эмиссионного" полупериода за счет усиления напряженности поля на вершине микровыступа возникает ток электронной эмиссии. В свою очередь объемный заряд эмитированных электронов экранирует электрическое поле на поверхности микровыступа. Появление эмиссионного тока сопровождается выделением энергии в микровыступе как за счет объемного Джоулева источника тепла, так и за счет кинетического поверхностного источника тепла (эффект Ноттингема). В силу резкой зависимости плотности тока электронной эмиссии от напряженности поля, требуется проведение самосогласованного расчета плотности эмиссионного тока, плотности объемного заряда, напряженности электрического поля при моделировании разогрева микроострия. Разогрев микровыступа приводит к появлению расплава в вершинной части, свободная поверхность которого оказывается под давлением со стороны электрического поля  $P_E = -\epsilon_0 \mathrm{E}^2/2$  и давлением сил поверхностного натяжения  $P_C = \gamma C$ . Движение расплава описывается системой уравнений Навье-Стокса для вязкой несжимаемой жидкости со свободной поверхностью.

### 2.2. Математическая модель

В рамках разработанной модели потенциал электрического поля U(r, z) рассчитывается из уравнения Пуассона в двумерной цилиндрической системе координат:

$$\Delta U(r,z) = -4\pi\rho(r,z), \tag{1}$$

где р – объемный заряд эмитированных электронов.

Уравнение (1) решается численно в расчетной области  $r_d = z_d = 10$  мкм (см. Рис.1). Потенциал микровыступа полагается нулевым, на левой и правой границе  $\partial U/\partial r$  (r=0,  $r=r_d$ ) = 0, а на верхней границе  $z=z_d$  задается  $z=z_d$  задается

$$z = z_0 + v_z^0 \Delta t, \qquad r = r_0 + v_r^0 \Delta t,$$

$$v_z = v_z^0 + \frac{e}{m} E_z(r, z) \Delta t, \qquad v_r = v_r^0 + \frac{e}{m} E_r(r, z) \Delta t,$$
(2)

где  $z_0$ ,  $r_0$  и z, r координаты частицы до и после шага по времени  $\Delta t$ ,  $v_z^0$ ,  $v_r^0$  и  $v_z$ ,  $v_r$  – компоненты скорости частицы до и после  $\Delta t$ ,  $E_z = -dU/dz$  и  $E_r = -dU/dr$  — компоненты напряженности электрического поля, e и m — заряд и масса электрона, соответственно. Частицы стартуют с поверхности микровыступа на каждом шаге по времени в результате термоавтоэлектронной эмиссии (TFE). Используется PIC схема суперчастиц с различным зарядом  $q_p$ . Этот заряд определяется при рождении частицы выражением  $q_p = j_{FE}\Delta S_i\Delta t$ , где  $j_{FE}$  плотность тока TFE,  $\Delta S_i$  — элементарная площадка эмитирующей поверхности с которой стартует частица,  $\Delta t$  — шаг по времени.

Плотность тока TFE  $j_{FE}$  рассчитывается в приближении Миллера-Гуда:

$$j_{\text{FE}} = \frac{4\pi me}{h^3} \int_{0}^{\infty} d\varepsilon \int_{0}^{\varepsilon} d\varepsilon_n f_{FD}(\varepsilon) D(E_c, \varepsilon_n), \qquad (3)$$

где  $D(E_c, \varepsilon_n)$  – коэффициент прозрачности потенциального барьера,  $E_c$  – напряженность поля у поверхности микровыступа,  $\varepsilon = (\hbar k)^2/2m$  – энергия электрона в металле в состоянии с волновым вектором k,  $\varepsilon_n = (\hbar k_n)^2/2m$  – "нормальная к барьеру" энергия электрона, h ( $\hbar = h/2\pi$ ) – постоянная Планка. Мы полагаем, что распределение электронов по энергиям определяется равновесной функцией Ферми-Дирака  $f_{FD}(\varepsilon) = \{1 + \exp((\varepsilon - \varepsilon_F)k_BT_e)\}^{-1}$ , где  $\varepsilon_F$  – энергия Ферми,  $k_B$  – постоянная Больцмана. В рамках приближения Миллера-Гуда выражение для  $D(E_c, \varepsilon_n)$  можно записать в следующем виде:

$$D(E_c, \varepsilon_n) = \begin{cases} \left[1 + \exp(Q(E_c, \varepsilon_n))\right]^{-1}, & \varepsilon_n < \varepsilon_L \\ 1, & \varepsilon_n > \varepsilon_L \end{cases}$$
(4)

$$Q(E_c, \varepsilon_n) = \frac{4\sqrt{2}}{3} \left( \frac{m^2 e^5}{\hbar^4 E_c} \right)^{1/4} y^{-3/2} v(y), \qquad (5)$$

$$y = \sqrt{e^3 E_c} / |\varepsilon_F + \phi - \varepsilon_n| \quad , \tag{6}$$

где  $\varepsilon_L = \varepsilon_F + \phi - (e^3 E_c/2)^{1/2}$ ,  $\phi$  – работа выхода, а функция  $\upsilon(y)$  определяется через эллиптические интегралы.

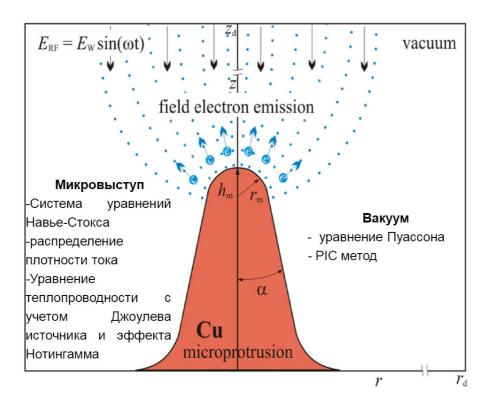


Рис.1. Модельная геометрия задачи.

Движение расплава описывается системой уравнений Навье-Стокса для вязкой несжимаемой жидкости со свободной поверхностью:

$$\frac{\partial u'}{\partial t} + u' \frac{\partial u'}{\partial r'} + v' \frac{\partial u'}{\partial z'} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial r'} + v \left( \frac{\partial^2 u'}{\partial r'^2} + \frac{\partial}{\partial r} \left( \frac{u'}{r'} \right) + \frac{\partial^2 u'}{\partial z'^2} \right) \tag{7}$$

$$\frac{\partial v'}{\partial t} + u' \frac{\partial v'}{\partial r'} + v' \frac{\partial v'}{\partial z'} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z'} + v \left( \frac{\partial^2 v'}{\partial r'^2} + \frac{1}{r'} \frac{\partial v'}{\partial r'} + \frac{\partial^2 v'}{\partial z'^2} \right), \tag{8}$$

и уравнения непрерывности, обеспечивающее условие несжимаемости:

$$\frac{1}{r'}\frac{\partial}{\partial r'}(r'u') + \frac{\partial v'}{\partial z'} = 0. \tag{9}$$

Здесь  $\vec{V}' = \langle u', v' \rangle$  — гидродинамическая скорость расплава, имеющего температуру T,  $\rho = \rho(T_j)$  — плотность, и  $\nu = \nu(T_j)$  — кинематическая вязкость. Уравнения (7)–(9) решаются численно с помощью проекционного метода. В рамках такого подхода необходимо решать уравнение Пуассона для давления на каждом шаге по времени. Для этого используются следующее граничное условие Дирихле для давления на свободной поверхности:

$$p|_{\Omega_{FS}} = p + \gamma C + 2\nu \rho \left[ \frac{\partial u'}{\partial r'} N_{r'}^2 + \frac{\partial v'}{\partial z'} N_{z'}^2 + \left( \frac{\partial v'}{\partial r'} + \frac{\partial u'}{\partial z'} \right) N_{r'} N_{z'} \right], \tag{10}$$

где  $\gamma = \gamma(T_j)$  коэффициент поверхностного натяжения, C – кривизна свободной поверхности расплава, и  $\vec{N} = \left\langle N_{r'}, N_{z'} \right\rangle$  – единичный вектор нормали к свободной поверхности. Для расчета движения фронта жидкости используется "particle level set function" метод [13].

Для расчета распределения плотности тока в микровыступе  $j=-\sigma \nabla U_{\Omega}$ , решается уравнение Лапласа на омический потенциал  $U_{\Omega}$ :

$$\frac{1}{r'}\frac{\partial}{\partial r'}\left(r'\sigma\frac{\partial U_{\Omega}}{\partial r'}\right) + \frac{\partial}{\partial z'}\left(\sigma\frac{\partial U_{\Omega}}{\partial z'}\right) = 0,$$
(11)

с граничными условиями:

$$-\nabla U_{\Omega}|_{S} = j_{S} / \sigma, \ \sigma \frac{\partial U_{\Omega}}{\partial r'} (r' = 0) = 0, \ U_{\Omega}(z' = 0) = 0,$$
 (12)

где  $\sigma$  – электропроводность расплава, зависящая от температуры.

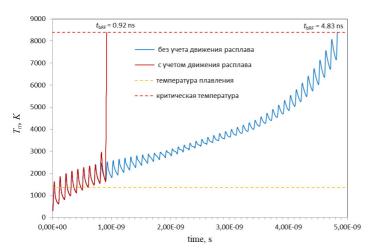
Температура микровыступа T(r',z',t) рассчитывается на основе уравнения теплопроводности с учетом конвективного переноса тепла, эффекта Джоуля и эффекта Ноттингема:

$$c\rho\left(\frac{\partial T}{\partial t} + \vec{V}\vec{\nabla}T\right) = \frac{1}{r'}\frac{\partial}{\partial r'}\left(r'\lambda\frac{\partial T}{\partial r'}\right) + \frac{\partial}{\partial z'}\left(\lambda\frac{\partial T}{\partial z'}\right) + \frac{j^2}{\sigma}.$$
 (13)

## 3. Результаты моделирования

Расчеты проводились для медного микровыступа с радиусом вершины  $r_{\rm m}=2\cdot10^{-8}$  м, высотой  $h_{\rm m}=2\cdot10^{-6}$  м и  $\alpha=2^{\circ}$  (см. Рис.1). Задавалось гармоническое СВЧ поле с амплитудой напряженности  $E_w=250$  МВ/м и частотой w=10 ГГц. Коэффициент усиления напряженности электрического поля на вершине такого микровыступа составляет  $\beta_m=86.5$ . На Рис.2 представлена динамика разогрева микровыступа, как с учетом изменения формы вершины после плавления (красная кривая), так и при неизменной форме микровыступа

(синия кривая). Последний случай детально нами исследовася в двухтемппературном приближении в [12, 14]. Как видно из Рис.2, на первой стадии до появления расплава температурные кривые совпадают. Здесь разогрев микровыступа практически целиком определяется выделением тепла за счет эмиссионного источника энергии — эффекта Ноттингема на "положительной" полуволне. В течение отрицательной полуволны происходит отвод тепла от вершины к основанию микровыступа за счет теплопроводности. Рост температуры микровыступа с течением времени усиливается уже за счет Джоулева разогрева. Однако после нагрева вершины микровыступа выше температуры плавления картина развития тепловой неустойчивости в рассматриваемых случаях существенно различаются.



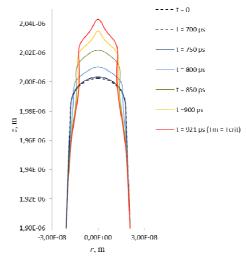


Рис.2. Динамика разогрева микровыступа до критической температуры в СВЧ поле без учета движения расплва (синия кривая) и с учетом изменения формы вершины микровыступа после плавления (красная кривая).

Рис.3. Динамика формы микровыступа после плавления. Время появления расплава  $t_m = 700$  пс.

Расчетные параметры:  $r_{\rm m} = 2 \cdot 10^{-8}$  м,  $h_{\rm m} = 2 \cdot 10^{-6}$  м,  $\alpha = 2^{\circ}$  ( $\beta_{\rm m} = 86,5$ ),  $E_{\rm w} = 250$  МВ/м, w = 10 ГГц.

Так при неизменной форме микровыступа время развития тепловой неустойчивости  $t_{\rm bRF}$ составляет 4.83 нс. В случае учета движения расплава под действием сил со стороны электрического поля и поверхностного натяжения это существенно меньше и составляет 0.92 нс от начала нагрева и 220 пс от момента плавления вершины микровыступа. На Рис.3 представлена динамика изменения формы вершинной части микровыступа после появления расплава (t<sub>m</sub> = 700 пс) под воздействием переменного гармонического электрического поля. Временная зависимость напряженности электрического поля и плотности тока электронной эмиссии на вершине микровыступа показана на Рис.4. Как видно из приведенных рисунков, после плавления вершина микровыступа в электрическом поле начинает вытягиваться и заострятся. Это приводит к существенному росту напряженности электрического поля и плотности тока электронной эмиссии (см. Рис.4). Так что в начале положительной полуволны (t = 900 пс) максимальная температура в микровыступе лишь немного превышает температуру плавления, развитие тепловой неустойчивости происходит очень быстро на первой четверти эмиссионной полуволны при плотностях тока  $1\cdot10^{10}$ – $4\cdot10^{10}$  А/см<sup>2</sup>. При этом за счет резкого роста напряженности поля эмиссионный источник выделения тепла (эффект Ноттингамма) всегда остается греющим. Это приводит к тому, что максимальная температура находиться на поверхности, а не в глубине вершины (см. Рис.5).

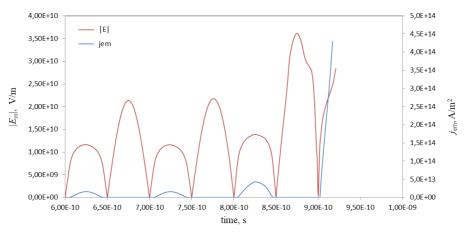


Рис.4. Временная зависимость напряженности электрического поля и плотности тока электронной эмиссии на вершине микровыступа. Время появления расплава  $t_{\rm m}=700$  пс. Расчетные параметры:  $r_m=2\cdot 10^{-8}$  м,  $h_m=2\cdot 10^{-6}$  м,  $\alpha=2^{\circ}$  ( $\beta_m=86.5$ ),  $E_w=250$  МВ/м, w=10 ГГц.

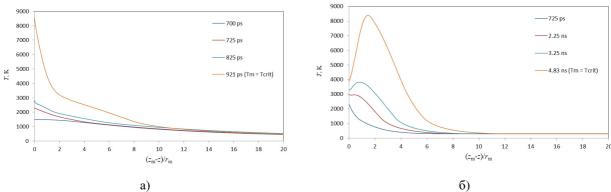


Рис.5. Распределение температуры вдоль микровыступа (ось z) в различные моменты времени с учетом изменения формы вершины – а); в статичном случае – б). Время появления расплава  $t_{\rm m}=700$  пс. Расчетные параметры:  $r_{\rm m}=2\cdot10^{-8}$  м,  $h_{\rm m}=2\cdot10^{-6}$  м,  $\alpha=2^{\circ}$  ( $\beta_{\rm m}=86.5$ ),  $E_{\rm w}=250$  МВ/м,  $\omega=10$  ГГц.

## 4. Выводы

Разработана двумерная осесимметричная модель развития тепловой электрогидродинамической неустойчивости в микровыступе, расположенном на стенке СВЧ структуры. Модель включает В себя самосогласованный расчет напряженности электрического поля и эмиссионных характеристик на "эмиссионной" полуволне СВЧ волны. С момента появления расплава в вершинной части микровыступа, модель описывает движение жидкой фазы под действием сил со стороны электрического поля (Maxvell stress) и сил поверхностного натяжения. Проведено самосогласованное моделирование изменения микровыступа с начальным формы вершинной части коэффициентом напряженности электрического поля  $\beta_m \sim 86$  и его разогрева в СВЧ волне с модулем напряженности 250 МВ/м и частотой 10 ГГц. Показано, что время развития тепловой неустойчивости при вытягивании и заострении микровыступа в расплавленном состоянии существенно ниже, чем в случае неизменной формы микровыступа. Так, при неизменной форме микровыступа время развития тепловой неустойчивости  $t_{bRF}$  составляет 4.83 нс. В случае учета движения расплава под действием сил со стороны электрического поля и поверхностного натяжения это существенно меньше и составляет 0.92 нс от начала нагрева и 220 пс от момента плавления вершины микровыступа. После плавления вершина микровыступа в электрическом поле начинает вытягиваться и заострятся. Это приводит к резкому росту напряженности электрического поля и плотности тока электронной эмиссии. При этом эмиссионный источник выделения тепла (эффект Ноттингамма) всегда остается греющим, а максимальная температура достигается на поверхности вершины вытягивающегося и заостряющегося микровыступа.

## Благодарности

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 20-19-00323).

# 5. Список литературы

- [1] Mesyats G.A., Proskurovsky D.I., *Pulsed Electrical Discharge in Vacuum*. (Berlin: Springer, 1989).
- [2] Mesyats G.A., Cathode Phenomena in a Vacuum Discharge: The Breakdown, the Spark and the Arc. (Moscow: Nauka, 2000).
- [3] Barengolts S.A., Kreindel M.Y., Litvinov E.A., *IEEE Trans. Plasma Sci.*, **26**(3), 252, 1998; doi: 10.1109/27.700751
- [4] Barengolts S.A., et al., *Phys. Rev. Accel. Beams*, **21**(6), 061004, 2018; doi: 10.1103/PhysRevAccelBeams.21.061004
- [5] Mesyats G.A., Pulsed Power, (New York: Springer Science & Business Media, 2007); url: https://download.e-bookshelf.de/download/0000/0000/73/L-G-0000000073-0002330886.pdf
- [6] Agee F.J., *IEEE Trans. Plasma Sci.*, **26**, 235, 1998; doi: 10.1109/27.700749
- [7] Aicheler M., et al., A Multi-TeV linear collider based on CLIC technology: CLIC Conceptual Design Report. (CERN-2012-007, 2012).
- [8] Wuensch W., *Advances in the understanding of the physical processes of vacuum breakdown*, (CERN-OPEN-2014-028, CLIC-Note-1025, 2013).
- [9] Mesyats G.A., *High Power Microwave Generation and Applications*, (Bologna: SIF, 1992).
- [10] Barengolts S.A., Mesyats V.G., Oreshkin V.I., Oreshkin E.V., Khishchenko K.V., Uimanov I.V., Tsventoukh M.M., *Phys. Rev. Accel. Beams*, 21, 061004, 2018; doi: 10.1103/PhysRevAccelBeams.21.061004
- [11] Simakov E.I., Dolgashev V.A., Tantawi S.G., *Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A*, 907 221, 2018; doi: 10.1016/j.nima.2018.02.085
- [12] Uimanov I.V., Shmelev D.L., Barengolts S.A., *J. Phys. D: Appl. Phys.*, **54**, 065205, 2020; doi: 10.1088/1361-6463/abc213
- [13] Enright D., Fedkiw R., Ferziger J., Mitchell I., *J. Comput. Phys.*, **183**(1), 83, 2002; doi: 10.1006/jcph.2002.7166
- [14] Barengolts S.A., Uimanov I.V., Shmelev D.L., *IEEE Transaction on Plasma Science*, **47**(8), 3400, 2019; doi: 10.1109/TPS.2019.2914562.